

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅用 / High Frequency Amplifier

通信工業用 / Industrial Use

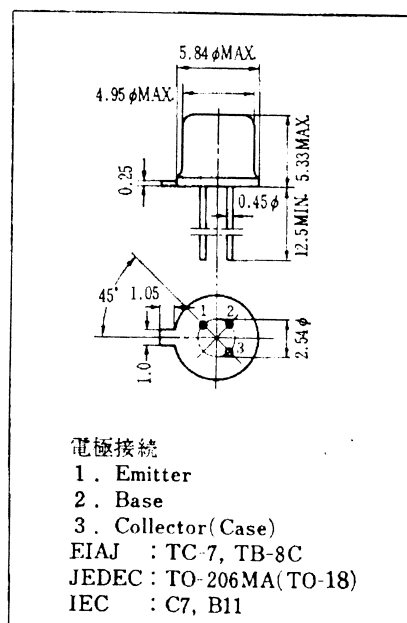
特 徴 / FEATURES

- ・高耐圧です。 $V_{CEO} : 40V$, $V_{EBO} : 8.0V$
High breakdown voltage.
- ・直流電流増幅率が高い。 $h_{FE} : 80 \sim 240$
High DC current gain.
- ・高周波増幅はもとよりスイッチング、低周波増幅などにも適します。
Suitable for switching and LF amplifiers as well as HF amplifiers.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	8.0	V
コレクタ電流	I_C	200	mA
全損失	P_T	300	mW
ジャンクション温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-65 \sim +150$	$^\circ C$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)



電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 40V, I_E = 0$			0.5	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5.0V, I_C = 0$			0.5	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 10mA$	80	150	320	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 100mA$	30	75		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100mA, I_B = 10mA$		0.12	0.70	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 100mA, I_B = 10mA$		0.85	1.20	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10V, I_E = -10mA$	150	250		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		3.4	5.5	pF
ターンオン時間	t_{on}			95		ns
蓄積時間	t_{stg}	測定回路図参照/See test circuit		190		ns
ターンオフ時間	t_{off}			240		ns

h_{FE} 区分 / h_{FE} Classification

$h_{FE1} / 80 \sim 130 \quad 110 \sim 170 \quad 150 \sim 240 \quad 200 \sim 320$

